

فصلنامه سیستمهای پردازشی و ارتباطی چندرسانهای هوشمند



Intelligent Multimedia Processing and Communication Systems (IMPCS)

تعیین توزیع حرارتی یک پست کمپکت

DOR: 20.1001.1.27832570.1399.1.1.4.8

مقاله پژوهشی

ميثم بهاروند

۱- موسسه تحقيقات ايران ترانسفو، زنجان، ايران meisam_baharvand@yahoo.com

چکیده: ترانسفورمرها یکی از اجزاء مهم پستهای کمپکت هستند و مطالعه رفتار مغناطیسی و حرارتی آنها در داخل پست، دارای اهمیت بسزائی می با شد. تعیین توزیع حرارتی در داخل ترانسفورمرها بعلت پیچیدگی هند سی ساختمان ترانسفورمر، وابسته بودن خواص مواد بکار رفته با درجه مرارت و غیرخطی بودن رفتار مغناطیسی آنها معمولا مشکل می باشد. در این بین استفاده از روشهای عددی همانند اجزاء محدود یک روش کارآمد حرارت و غیرخطی بودن رفتار مغناطیسی آنها معمولا مشکل می باشد. در این بین استفاده از روشهای عددی همانند اجزاء محدود یک روش کارآمد برای تعیین توزیع حرارتی داخل ترانسفورمر و نیز تعیین حداکثر دمای سیم پیچیهای ترانسفورمر می باشد. در این پیان استفاده از روشهای عددی همانند اجزاء محدود یک روش کارآمد برای تعیین توزیع حرارتی داخل ترانسفورمر و نیز تعیین حداکثر دمای سیم پیچیهای ترانسفورمر می باشد. در این پایان نامه با استفاده از روشهای معدی می بودن رفتار مغناطیسی آنها معمولا مشکل می باشد. در این بین استفاده از روشهای عددی همانند اجزاء محدود یک روش کارآمد برای تعیین توزیع حرارتی داخل ترانسفورمر و نیز تعیین حداکثر دمای سیم پیچیهای ترانسفورمر می باشد. در این پایان نامه با استفاده از برای تعیین توزیع حرارتی دار می باز سی بایان نامه با استفاده از مدای در این بین استفاده از مای برای معمولم رو نیز تعیین محدود تو سط نرم افزار ان سیس توزیع حرارتی سیم پیچیهای تران سفورمر در شرایط نرمال بهره برداری در فضای باز و نیز در شرایطی که تران سفورمر در داخل پ ست کمپکت قرار دارد تعیین می شود و با توجه به اختلاف دمای حداکثر دمای سیم پیچها در دو شرایم کلاس حرارتی پست کمپکت تعیین می شود از دارد تعیین می شود و با توجه به اختلاف دمای حداکش سیم پیچها در دو شرایط کلاس حرارتی پست کمپکت تعیین می شود.

واژههای کلیدی: اجزاءمحدود، جهش حرارتی، پست کمپکت، ترانسفورماتور

Thermal analysis of a compact Substation

Meisam Baharvand¹

1- Irantransfo Research Center, Zanjan, Iran, meisam_baharvand@yahoo.com

Abstract: Transformers are one of the most important components of compact substations and the study of their magnetic and thermal behavior inside the substation is very important. Determining the thermal distribution inside transformers is usually difficult due to the geometric complexity of the transformer structure, the dependence of the properties of the materials used on the temperature, and the nonlinearity of their magnetic behavior. In the meantime, the use of numerical methods such as finite elements is an efficient method to determine the thermal distribution inside the transformer and also to determine the maximum temperature of the transformer windings. In this dissertation, using magnetic and two-dimensional thermal analysis of finite elements by Ansys software, the thermal distribution of transformer windings in normal outdoor operation conditions and also in conditions where the transformer is located inside the compact substation is determined and according to The temperature difference of the maximum temperature of the windings in the two conditions determines the thermal class of the compact.

Keywords: Finite Elements, Temperature Rise, Compact substation, Transformer

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

۱– مقدمه

تراکم بار در مناطق مرکزی محیطهای شــهری و قیمت بالای زمین و عدم دسترسی به زمینهای با ابعاد مناسب برای سـاخت پسـتهای معمولی توزیع، موجب گسـترش اسـتفاده از انواع پسـتهای کمپکت پیش ساخته شده است. پستهای کمپکت پیش ساخته به پستهایی اطلاق میشود که بدون نیاز به عملیات سـاختمانی و به صورت آماده شـده از قبل و یا با حداقل عملیات سـاختمانی قابل نصـب در محل با شند. از دیگر مزایای پستهای کمپکت ایمنی و ضریب اطمینان بالا، سهولت فراوان عملیات حمل و نصب، سرعت بالای عملیات نصب و راهاندازی، عدم نیاز به عملیات سـاختمانی وصـرفه جویی در هزینهها، اقتصادی بودن اسـتفاده از آن در جاهایی که قیمت زمین بالا است، انعطاف پذیری در چیدمان اجزاء و نحوه اتصـالات در شـبکه فشـار متوسـط و فشـار ضـعیف و نیز سـرعت عمل در نصـب و راهاندازی میباشد [2, 1].

یکی از تایپ تستهای مربوط به پست کمپکت تست برر سی افزایش درجه حرارت تجهیزات اصلی پست کمپکت میباشد این تست با اندازه گیری افزایش دمای روغن و سیم پیچی ترانسفورمر(برای ترانسفورمر خشک فقط سیم پیچی) و افزایش دمای تجهیزات فشار ضعیف انجام میشود. تست باید نشان دهد که افزایش دمای ترانسفورمر داخل پست کمپکت نسبت به افزایش دمای همان ترانسفورمر در خارج پست، از مقدار معینی بیشتر نیست. این مقدار معین، کلاس حرارتی پست را مشخص میکند (به عنوان مثال ۲۰۴).

یکی از مهمترین اجزاء پستهای کمپکت، ترانسفورمر است که قسمت فشار متو سط و فشار ضعیف داخل پست را به هم مرتبط می سازد. عوامل متعددی از قبیل بهرهبرداری غلط که ناشی از عدم دستر سی به اطلاعات جامع درخصوص ترانسفورمر است، موجب به وجود آمدن شرایط بحرانی برای آن میشود. این شرایط بحرانی علاوه بر اینکه منجر به کاهش طول عمر ترانسفورمرها و تحمیل هزینههای تعمیرات منجر به کاهش طول عمر ترانسفورمرها و تحمیل هزینههای تعمیرات رانسفوماتورها و به دنبال آن محدودیت در انتقال قدرت در شبکه می شود. تلفات هسته و سیمپیچیهای ترانسفورمر باعث تولید گرما و افزایش دمای سیمپیچیهای ترانسفورمر می شود. افزایش غیر مجاز دمای سیمپیچیهای ترانسفورمر، در اثر افزایش نامناسی ضریب بار عایق سیم پیچیها و گاها شکست عایقی و در نهایت کاهش طول عرترانسفورمر می شود.

تست جهش حرارتی در آزمایشگاهها به علت هزینه بالا و طولانی بودن زمان تست و نیز مشکلات حمل و نقل به آزمایشگاهها چندان مورد درخواست کارخانجات سازنده نمی باشد و آنها به دنبال روشهای جایگزینی هستند که کم هزینه تر و سریعتر با شد. اما با توجه به اینکه تعیین توزیع دمایی دقیق تمامی نقاط ترانسفورمر، به خاطر پیچیدگیهایی که در ساختمان ترانسفورمر وجود دارد و نیز نیاز به

محاسبات طولانی و وقت گیر دارد مدلهای ارائه شده مدلهای دقیقی نبودهاند. با مطرح شدن روشهای کامپیوتر مبنا همانند اجزاء محدود و به وجود ا مدن نرم افزار های مختلف مثل Ansys، که قابلیت حل مجموعهای از معادلات دیفرانسیل را بطور همزمان دارند، بدست آوردن مدل حرارتی برای ترانسفورمرها به مساله تعیین توزیع حرارت برای ترانسفورمر ها تبد یل شـد. در این مقا له ابتدا توزیع حرارتی سیمپیچیهای ترانسفورمر را یکبار در شـرایط نرمال (محیط باز ، بار کامل و دمای محیط ۲۰ درجه سانتی گراد) و یکبار وقتی ترانسفورمر در بدست آورده و حداکثر دمای سیمپیچیهای ترانسفورمر را در هر دو شـرایط تعیین می کنیم سـپس با مقایسه این دو دما کلاس حرارتی پست کمپکت را تعیین می کنیم.

۲- تئوری ریاضی

هر امروزه رو شهای عددی که بر پایه حل مسائل با محا سبات تقریبی هستند گسترش پیدا کردهاند، گرچه اکثر این روشها چندان جدید نی ستند و در گذ شته نیز از انها برای تحلیل م سائل ا ستفاده می شده است اما حجیم و وقت گیر بودن این محاسبات باعث منسوخ شدن این روشها شده بود که با بوجود آمدن کامپیوترها و قابلیت انها در انجام محاسبات تکراری و حجیم، استفاده و گسترش این روشهای عددی توسط مهندسین مرسوم گردید. امروزه روشهای عددی متنوعی بسته به نوع روش و نوع تقسیمبندی فضای مساله برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر مسائل مورد استفاده قرار می گیرد که از ان جمله میتوان به روشهای اجزاء محدود، حجم محدود، تفاضل محدود و ... روش اجزاء محدود به حل مسائل پیچیده الاستیسیته و تحلیل سازهها در مهندسی عمران و هوا فضا برمی گردد. این روش حاصل کار الکساندر هرنیکوف و ریچارد کورانت میباشد. روش اجزاء محدود را میتوان به هرنیکوف و ریچارد کورانت میباشد.

- تقسیم ناحیه مورد نظر به تعداد زیادی زیر فضا کوچک موسوم
 به اجزاء که نقاط اتصال این اجزاءها به یکدیگر، گره نامیده
 می شود.
- تعیین تقریب اولیه برای حل به صورت یک تابع با ضرایب ثابت مجهول که همواره یا خطی و یا از مرتبه دوم است. که پس از تعیین شدن مرتبه تقریب اولیه، معادله حاکم در هر گره نوشته میشود.
- استخراج دستگاه معادلات جبری، که در صورت استفاده از روش گالرکین، تابع وزنی برای هر گره مشخص شده و سپس انتگرال باقیمانده وزنی تشکیل میگردد. با انتگرال گیری، برای هر گره یک معادله جبری ایجاد میگردد که پس از استخراج معادلات همه گرهها، دستگاه معادلات بوجود میآید.
 - حل دستگاه معادلات ایجاد شده
 - محاسبه سایر کمیات از روی مقادیر گرهی

۱-۲ توسعه معادلات الكترومغناطيسى

با فرض وابسته بودن مشخصات الکتریکی مواد با درجه حرارت صورت کلی معادله پواســن در مورد یک میدان مغناطیســی متغییر با زمان به صورت زیر است:

$$\nabla .(\upsilon_r(T)\nabla A) - \mu \sigma(T)\frac{\partial A}{\partial T} = -\mu J_0 \tag{1}$$

در یک محیط دو بعدی A مولفه Z از پتانسیل مغناطیسی متغییر با زمان بوده که به صورت زیر تعریف می شود:

$$A(t) = Ae^{j\omega t} \tag{(1)}$$

با ا ستفاده از مختصات کارتزین معادله رابطه (۱) به صورت زیر نو شته میشود:

$$\frac{1}{\mu}\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{1}{\mu}\frac{\partial^2 A}{\partial y^2} = -J_0 + j\omega \, \alpha A \tag{(7)}$$

که در آن µ ضـریب نفوذ پذیری، σ رسـانایی الکتریکی و Jo چگالی جریانهای ادی است.

۲-۲ محاسبه تلفات ترانسفورماتور

۲–۲–۱ تلفات هسته

هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقههای ناز کی است که سطح آنها با توجه به ظرفیت ترانسفورماتورفور ماتورها محاسبه می شود. قسمت عمده تلفات بی باری ترانسفورماتورها مربوط به تلفات هسته آهنی ترانسفورماتور است کیفیت هسته تاثیر به سزایی در مقدار این تلفات دارد. برای کم کردن تلفات آهنی هسته ترانسفورماتور معمولاً آنها را از ورقههای نازک فلزی که نسبت به یکدیگر عایق هستند، می سازند این ورقهها از آهن بدون پسماند با آلیاژی از سیلیسیم که دارای قابلیت هدایت الکتریکی و قابلیت هدایت مغناطیسی زیادی است ساخته می شوند.

تلفات هســته عموما ناشــی از تلفات هیســترزیس و تلفات جریانهای گردابی میباشد. تلفات جریانهای گردابی توسط رابطه (۴) قابل محاسبه میباشد [3].

$$P_E = \frac{\omega^2 \gamma_c}{24} \varepsilon^2 B_{Max}^2 V_{core} \tag{f}$$

در را بطه فوق γ_c ضریب هدایت مغناطیسی صفحات در واحد حجم، \mathcal{V}_c فخامت صفحات مغناطیسی، V_{core} حجم موثر هسته میبا شد، ضخامت صفحات ثابت در نظر گرفته شده است.

تلفات هیسترزیس در اثر خاصیت پس ماند مغناطیسی در هسته ترانسفورماتور ایجاد می شود . مقدار تلفات هیسترزیس نسبت به تلفات گردابی در یک ترانسفورماتور تغذیه کمتر است چرا که مقدار تلفات هی سترزیس بستگی به فرکانس دا شته و در فرکانسهای پایین مقدار آن کمتر است، اما مقدار آن با افزایش فرکانس به شدت افزایش می یابد. برای محاسبه تلفات هیسترزیس در یک مدار مغناطیسی با چگالی شار یکنواخت متناوب می توان از رابطه زیر استفاده کرد [3]. (۵)

$$P_{H} = \frac{\omega}{2\pi} k_{H} V B_{Max}^{\nu}$$

شریب هیسترزیس ماده هسته، v ضریب تجربی اشمیتز میباشد k_H که میتواند بین 1/8 تا 1/8 تغییر کند. در نهایت تلفات هسته شامل مجموع این دو تلفات میباشد:

$$P_{core} = P_E + P_H \tag{(\%)}$$

۲-۲-۲ تلفات سیم پیچها

تلفات سیمپیچهای ترانسفورماتورها هنگامی که تحت بار هستند شامل دو بخش می شود بخش اول این تلفات ناشی از تلفات مسی سیمپیچها بوده و بخش دوم اختصاص به تلفات ناشای از جریانهای گردابی در سطح مقطع سیمپیچها دارد بر خلاف حالت بی باری ترانسفورماتور می توان از تلفات جریانهای گردابی صرف نظر کرد، اینجا میزان تلفات گردابی با افزایش بار افزایش می ابد [4].

تلفات مسی همانطور که از نامش پیداست ناشی از عبور جریان از مقاومت سیم پیچیها است که میتواند از طریق تست اتصال کوتاه ترانسفورماتور تحت جریان نامی تعیین شود. اگر از تلفات هسته در این حالت صرف نظر کنیم میتوان تلفات اتصال کوتاه را به عنوان تلفات سیم پیچی ها در نظر گرفت. تلفات اتصال کو تاه در جریان نامی ترانسفورماتور برابر است با

$$P_{cc} \approx P_{winDC} = R \cdot I_R^2 = \frac{1}{\gamma_w} \frac{l_w}{A_c} I_R^2$$
(Y)

که در آن γ_w ، رسانایی الکتریکی سیم پیچیهاست، l_w ، طول سیم بندی سیم پیچیهاو I_w ، طول سیم بندی سیم پیچیها و I_R ، جریان نامی ترانسفورماتور میباشد[4].

۲-۳ توسعه معادلات حرارتی

بین دو محیط که اختلاف دمایی وجود دارد تبادل گرمایی صورت می گیرد، انتقال گر ما بین دو محیط به شیوه های مختلفی انجام می شود. وقتی در محیط ساکنی که می تواند جامد یا سیال باشد شیب دما وجود دارد، انتقال گرما در آن به صورت رسانش صورت می گیرد. برای انتقال گرما بین سطح و سیالی متحرک که دمای آنها با هم متفاوت است از واژه جابجایی استفاده می شود. نوع سوم انتقال گرما تشعشع گرمایی است. تمام سطوح با دمای معین انرژی را بشکل امواج الکترومغناطیسی گسیل می دارند. از این رو در نبود محیط واسط میان دو سطح با دمای مختلف انتقال گرمای تشعشعی وجود دارد.

معادلات آهنگ رسانش گرما به قانون فوریه معروف است. در حالت کلی گرادیان گرمایی ایجاد شده در اثر وجود شار گرمایی در مورد یک جسم در حالت سه بعدی را بر طبق قانون فوریه به صورت زیر میتوان بیان کرد [5]:

$$q'' = -k_x \frac{\partial T}{\partial x} - k_y \frac{\partial T}{\partial y} - k_z \frac{\partial T}{\partial z} \tag{A}$$

 k_z, k_y, k_x و تا T شار گرمایی و T در جه حرارت ماده، q'' شار گرمایی و T رسانندگی گرمایی در جهت محورهای y, x و z است. شار گرمایی به انتقال گرما در واحد سطح گفته می شود. شود.

۳- تحلیل اجزا محدود پست کمپکت در حوزه حرارتی ۳-۱ مدلسازی سیمپیچیهای ترانسفورماتور

مشخصات حرارتی مواد هادی و عایق بکار رفته در ترانسفورماتورفورمرها عموماً ثابت نبوده و تابعی از درجه حرارت ا ست. مدل سازی حرارتی تک تک سیم پیچهای ترانسفورماتورفورمرها در محیط المان محدود به خاطر بالا بودن تعداد دور سیم پیچها و متفاوت بودن مشخصات عایقی مواد به کار رفته در آنها مشکل و غیرممکن است. همچنین بهخاطر سیم پیچهای فشار قوی و فشار ضعیف، استفاده از یک مدل واحد بمنظور مطالعه حرارتی آنها دقیق نمی باشد. درمورد سیم پیچهای فشار قوی به خاطر استفاده از سیم پیچی های نوع رشته ای و به علت متقارن بودن توزیع مواد هادی و عایقی استفاده شده در آنها رفتار کل سیم پیچها را می توان همانند یک جسم همگن با م شخ صات حرارتی معادل که به صورت زیر تعریف می شود در نظر گرفت [6]:

$$\lambda^{AB} = \frac{\lambda^{A}V^{A} + \lambda^{B}V^{B}}{V^{A} + V^{B}}$$

$$C^{AB} = \frac{C^{A}\rho^{A}V^{A} + C^{B}\rho^{B}V^{B}}{\rho^{A}V^{A} + \rho^{B}V^{B}}$$

$$\rho^{AB} = \frac{\rho^{A}V^{A} + \rho^{B}V^{B}}{V^{A} + V^{B}}$$
(9)

ho که در آن ، ضــریب هدایت گرمایی، ظرفیت گرمایی ویژه، hoچگالی حجمی و حجم است. که بالا نویسها بترتیب نشان دهنده هادی و عایق است.

در سیمپیچهای فشار ضعیف به خاطر استفاده از سیمپیچهای فویلی و نیز به خاطر متفاوت بودن ضخامت لایه عایقی بکار رفته در امتداد محور x و y، رفتار حرارتی کل سیمپیچها نمیتواند همانند یک جسم همگن در نظر گرفته شود. بنابر این سیمپیچهای فشار ضعیف را میتوان همانند یک جسم غیرهمگن با ضریب هدایت حرارتی متفاوت در امتداد محور x و y، تصور نمود.

با توجه به اینکه ارتفاع کل سیمپیچهای فشار ضعیف در مقایسه با عرض آنها بسیار بیشتر میبا شد، با تقریب میتوان تصور نمود که شار حرارتی ایجاد شده ناشی از تلفات سیمپیچها فقط در جهت محور x و عمود بر ارتفاع سیمپیچها انتقال مییابد. بنابراین گرادیان دما در جهات x و y ناچیز و قابل صرفنظر کردن میبا شد. شار حرارتی در جهت x از سیمپیچها توسط دو ضریب هدایت حرارتی و \sqrt{k} منتقل میشود.

ضـریب هدایت حرارتی معادل در جهت عمود بر فویلها بوده و به صورت هدایت حرارتی معادل دو مسیر حرارتی سری که شامل هادی و عایق است تعریف میشود [7]، یعنی:

$$\lambda_{x} = \frac{d_{A} + d_{B}}{\frac{d_{A}}{\lambda_{A}} + \frac{d_{B}}{\lambda_{B}}}$$
(1.)

 λ_y .در رابطه مذکور d_A , d_A مخامت محیط مورد نظر میباشد. δ_y . ضریب هدایت حرارتی معادل در جهت فویل ها بوده و به صورت ضریب

هدایت حرارتی معادل دو مسیر حرارتی موازی که شامل هادی و عایق است تعریف میگردد:

$$\lambda_{y} = \frac{\lambda_{A}d_{A} + \lambda_{B}d_{B}}{d_{A} + d_{B}} \tag{11}$$

-Y محاسبه شرط مرزی همرفت بر روی دیواره سیم پیچها همانطور که قبلا ذکر شد برای حل مدل ارائه شده در محیط المان محدود نیازمند به دانستن شرایط مرزی هستیم. یکی از شرایط مرزی که معمولاً توسط روشهای محاسباتی قابل محاسبه میباشد، شرط مرزی ضریب همرفت است که لازم است بر روی دیوارههای سیم پیچها معلوم باشد. مقدار این ضریب معمولاً ثابت نبوده و تابعی از ارتفاع، درجه حرارت سطح، مشخصات فیزیکی سیال اطراف سیم پیچها و هندسه سطح میباشد. در هر مکان y از ارتفاع سیم پیچیها مکانی مانند (y) میباشد. در شاره وجود دارد که درجه حرارت آن ۰٫۹۹ درجه حرارت سیال میباشد. مکان هندسی چنین نقاطی لایه مرزی گرمائی نامیده میشود. طبق نظریه Eckert ضخامت این لایه در داخل سیال توسط رابطه زیر حساب میشود[8]:

$$\delta(y) = 3.93 \cdot y \cdot \Pr^{-0.5} (0.92 + \Pr)^{0.25} Gr^{-0.25}$$
(12)

 \Pr که در آن $\delta(y)$ ضـخامت لایه مرزی، y ارتفاع سـیم پیچی، ρ ضریب بی بعد پراندالت و Gr ضـریب بی بعد گراشـهف میباشـد، که بهصورت زیر محاسبه میشود:

$$Gr(y) = \frac{g\beta q_W'' y^4}{\lambda v^2} \tag{137}$$

که در آن g شتاب جاذبه زمین، β ضریب انبساط حجمی، q_W'' شار حرارتی منتقل شده از سطح سیم پیچها و v ویسکوزیته سیال می اشد.

با توجه به روابط (12) و (13) و با فرض دانستن مشخصات حرارتی روغن، حداکثر ضخامت لایه مرزی گرما در حداکثر ارتفاع سیم پیچها، با فرض حداکثر میانگین درجه حرارت روغن داخل کانال برابر با ۱۰۰ درجه سانتیگراد، به صورت زیر خواهد بود:

$$Gr|_{y=0.28} = 2.7 \times 10^{10}$$
 (14)

$$\delta|_{y=0.28} = 1.06 \times 10^{-3} (m)$$

همانطور که ملاحظه می شود حداکثر ضخامت لایه مرزی گرمائی در مقایسه با عرض کانال بین سیم پیچها که برابر ۴ میلیمتر است بسیار کوچک می باشد. بر طبق نظریه Ercket برای حالتی که ضخامت لایه مرزی سیال در بالاترین نقطه سیم پیچها در مقایسه با عرض کانال کوچک باشد جریان سیال داخل کانال آرام بوده و ضریب همرفت توسط رابطه تجربی زیر محاسبه می گردد:

$$h(y) = \frac{Nu(y) \times \lambda}{y}$$

$$Nu(y) = 0.6(Gr(y) \times Pr)^{0.2}$$
(15)

که در آن Nu(y) عدد بدون بعد ناسلت است.

۳-۳ محاسبه ضریب تابش

بطور کلی تشعشع میتواند توسط بازتاب و گسیل از سطحی خارج شود و با رسیدن به سطح دیگر بازتاب و جذب شود. این مساله برای سطوحی که میتوان آنها را اجسام سیاه گرفت ساده میشود، زیرا هیچ بازتابی وجود ندارد. لذا انرژی فقط با گسیل خارج میشود و تمام تشعشع فرودی جذب می شود. در حالت ایدهال جسم سیاه به جسمی گفته میشود که تمام تشعشع فرودی را با هر طول موج و در هر جهت جذب می کند و لزوما جسم سیاه سیاه نیست. در اینجا فرض می شود که سطوح خارجی تران سفورماتور و دیوارههای پست در تعریف جسم سیاه می گنجد.

آهنگ ت شع شعی گرما که از سطح i خارج می شود و تو سط سطح j دریافت می شود را می توان توسط رابطه زیر تعریف کرد:

$$I_{ij} = A_i F_{ij} \sigma (T_i^{4} - T_j^{4})$$
 (19)

که در آن σ ثابت ا ستفان بولتزمن و A_i مساحت سطحی ا ست که تشعشع از آن صورت می گیرد. F_{ij} کسری از تشعشع خروجی از سطح i است که توسط سطح j دریافت می شود است که به آن ضریب دید نیز گفته می شود. برای سطوح خارجی تران سفور ماتور و دیوارههای پست این سطوح به صورت سطوح موازی و عمود برهم در مقابل هم قرار گرفتهاند.

(17)
ضریب دید دو سطح موازی را می توان از رابطه زیر تعیین کرد [9]:

$$F_{ij} = \frac{\sqrt{[(W_i + W_j)^2 + 4]} - \sqrt{[(W_j - W_i)^2 + 4]}}{2W_i}$$

$$W_i = \frac{W_i}{L}$$

$$W_j = \frac{W_j}{L}$$

که در آن w_i و w_j بترتیب طول سطوح مقابل هم یا موازی هم و L فاصله دو سطح از هم است. رابطه ضریب دید برای دو سطح عمود بر هم را نیز می توان از رابطه زیر بدست آورد:

$$F_{ij} = \frac{1 + (w_j / w_i) - \sqrt{[1 + (w_j / w_i)^2]}}{2}$$
(1A)

با استفاده ضریب دید مربوط به سطوح در دو حالت میتوان رابطه انرژی گسیل شده از سطوح خارجی ترانسفورماتور به سطوح دیوارههای پست را برای استفاده در تحلیل اجزا محدود تعیین کرد.

۴– نتایج شبیه سازیها

در مثال شبیه سازی زیر به تحلیل حرارتی یک پست کمپکت ۵۰ کیلو ولت آمپر میپردازیم که مشـخصـات ترانسـفورماتور آن در جدول (۱) آورده شده است.

ابــعــاد مــحــوظــه ترانسفورماتور	74 × 33 × 67	جریـان نـا می فشار قوی	1.44A
ابعاد هسته	48 ×× 54	جریان نامی فشار ضعیف	72A
ابعاد پنجره	28 × 24	ولتاژ نامی فشار قوی	20kV
ابعاد ساقها	10 × 10	ولتاژ نامی فشار ضعیف	400V
ابعاد ســــيمپيچىھاى فشار قوى	2 × 24	مقاومت سیم پیچی فشـــار قوی	121.5 Ω
ابعاد س <u>یمپیچی</u> های فشار ضعیف	1.2 × 23	مقاومت ســـیم پیچی فشـــار ضعیف	0.03Ω
ظرفیت نامی	50kVA	جریان نا می فشار قوی	1.44A

۴-۱ محاسبه تلفات با استفاده از آنالیز مغناطیسی اجزاء محدود شکلهای (۱) و (۲) نحوه مش بندی فضای داخل پست و ترانسفور ما تور را نشان می دهد.



شکل۱: مش بندی پست کمپکت بهمراه ترانسفورماتور

برای تعیین تلفات بی باری هسته چگالی جریان بیباری به طرف فشار متو سط تران سفورمر بعنوان شرط مرزی آنالیز الکترومغناطیسی اجزاء محدود، اعمال می شود و سپس تحلیل الکترومغناطیسی حالت ماندگار برای بدســـت آوردن چگالی فلو مغناطیســی در هر کدام از المانهای هسته، بر ا ساس منحنی مغناطیس شوندگی ه سته انجام می گیرد. با توجه به معلوم بودن چگالی فلو در هر کدام از المانهای هسته میتوان تلفات ه سته را با استفاده از دیتا شیتهای مربوط به تران سفورمر مورد

ميثم بهاروند

نظر محاسبه کرد. شکل (۳) پراکندگی شار مغناطیسی داخل هسته را نشان میدهد.



شکل۲ : مش بندی ترانسفورماتور



شکل ۳: توزیع شار مغناطیسی داخل هسته ترانسفورمرفورمر در تحلیل الکترومغناطیسی حالت ماندگار اجزاء محدود

همچنین برای بد ست آوردن تلفات dc سیمپیچیهای ترانسفورمر باید چگالی جریانهای نامی ترانسفورمر به سیمپیچهای اولیه و ثانویه بعنوان شرط مرزی آنالیز الکترومغناطیسی اجزاء محدود، اعمال شود و سپس تحلیل الکترومغناطیسی هارمونیکی توسط نرم افزار بر روی مساله انجام شود. همین طور برای تعیین تلفات جریانهای گردابی سیمپیچیهای ترانسفورمر تحلیل هارمونیکی اجزا محدود با اعمال جریانهای اتصال

کوتاه به سیمپیچیهای فشار ضعیف و فشار متوسط بعنوان شرط مرزی صورت میگیرد. شـکل (۴) نحوه توزیع شـار مغناطیسـی در هسـته ترانسفورمر و در اطراف آن را نشان میدهد.



شکل ۴: توزیع شار مغناطیسی درون محفظه ترانسفورماتورفورمر در تحلیل الکترومغناطیسی هارمونیکی اجزاء محدود در $\omega t = 0$ در نهایت پس از محاسبه کلیه تلفات، بر اساس قانون جمع آثار، کلیه مقادیر تلفات با همدیگر جمع شده و به عنوان شرایط مرزی به مساله تحلیل حرارتی اجزاء محدود اعمال می شود. خلاصهای از نتایج در جدول (۲) آورده شده است.

تحليل مغناطيسيي	م_ق_ادي_ر	
اجزاء محدود	واقعى	نوع تلقات
729/66	146/V4	تلفات DC در سیم پیچی فشار
	ωιτ/τι	قوى
~\\// 7 6	414/94	تلفات DC در سیم پیچی فشار
	1 / 1 / 1 /	ضعيف
54/9	54/WX	تلهات جر یادهای گردابی در
7.17	/ 1/1 X	سیم پیچی فشار قوی
	١/٣٨	تلهات جریانهای گردابی در
_	1/1 X	سیم پیچی فشار ضعیف
۱۵۶/۱۸	10/04	هسته

جزاء محدود	مغناطیسی ا	تحليلهاي	۲: نتایج	جدول
	G	0		UJ ·

۲-۴ تعیین توزیع حرارتی داخل ترانسفورماتور:

برای اینکه بتوان تغییرات دمایی ناشـی از قرار گرفتن یک ترانسـفورمر در داخل یک پسـت کمپکت را بررسـی کرد لازم اسـت که دو تحلیل حرارتی اجزاء محدود جداگانه صـورت پذیرد. یکی از این تحلیلها برای

تعیین نحوه توزیع حرارتی سیمپیچیهای ترانسفورمر در شرایطی که ترانسفورمر در خارج از کانکس پست و در معرض دمای محیط قرار دارد، است، و تحلیل دیگر مربوط به وقتی است که ترانسفورمر در دا خل کانکس قرار میگیرد. در تحلیل حرارتی اجزاء محدود وقتی انزانسفورماتور در خارج از پست قرار دارد، شرایط مرزی که به تحلیل افزوده می شود شامل شرایط مرزی همرفت و نیز نرخ تولید انرژی یا همان گرمای ناشی از تلفات هسته و سیم پیچیها است و نیز در تحلیل قرار دارد، شرایط مرزی که به تحلیل افزوده می شود شامل شرایط مرزی همرفت، شرایط مرزی تابش و نیز نرخ تولید انرژی یا همان گرمای ناشی از تلفات هسته و سیم پیچیها می است و نیز در تحلیل افزوده می شود شامل شرایط و فشار قوی حاصل از تحلیل حرارتی اجزاء محدود، وقتی ترانسفورماتور و فشار قوی حاصل از تحلیل حرارتی اجزاء محدود، وقتی ترانسفورماتور در داخل پست قرار ندارد را نشان می دهد.



شکل ۵: توزیع دمایی سیمپیچهای فشار ضعیف در شرایطی که ترانسفورماتور در داخل پست کمپکت قرار ندارد

شکل ۶: توزیع دمایی سیمپیچهای فشار قوی در شرایطی که ترانسفورماتور در داخل پست کمپکت قرار ندارد

همانطور که شکل (۵)، (۶) نشان میدهد بیشترین دمای سیمپیچیهای فشار ضعیف و فشار قوی در شرایطی که ترانسفورماتور در داخل پست کمپکت قرار ندارد، به ترتیب ۸۷/۲۵ و ۷۸/۰۴ در جه سانتی گراد میباشد، که این مقادیر با نتایج اندازه گیریهای عملی که در جدول (۳) آمده است نیز مطابقت دارد [10].

محدود			
		بیشـــترین دمـای	بیشــترین دمای
		سیمپیچیهای فشار	ســـيم پيچىھـاى
		ضعيف	فشار قوى
ہای	ا ندازه گیریچ	۸۹ در جه ســانتی	۸۱ در جه ســانتی
	آزمایشگاهی	گراد	گراد
جزاء	تحليل اج	۸۷/۲۵ درجه سانتی	۷۸/۰۴ درجـــه
	محدود	گراد	سانتی گراد

جدول ۳: مقایسه نتایج اندازه گیری عملی و تحلیل حرارتی اجزاء

برای تعیین مقدار افزایش دمای سیمپیچیهای ترانسفورماتور، وقتی ترانسفور ماتور در دا خل پست کمپکت قرار دارد، توزیع د مایی سیمپیچیهای فشار قوی و فشار ضعیف آن در اشکال (۷) و (۸) آورده شده است.



شکل ۷: توزیع دمایی سیمپیچهای فشار ضعیف وقتی ترانسفورماتور در داخل پست کمپکت قرار دارد

همانطور که در شکلها نیزدیده می شود میزان افزایش دمای بیشترین دمای سیم پیچی فشار ضعیف وقتی در داخل پست کمپکت قرار می گیرد تقریبا هر کدام در حدود شش درجه سانتی گراد خواهد بود. این مقدار افزایش در جه برای یک پست کمپکت ۵۰ کیلو ولت آمپری که دمای محیطی که در آن قرار می گیرد ۲۰ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است معقول می باشد. البته در بررسی چند نمونه از گزارشهای تستهای افزایش دما انجام شده بر اساس استاندارد IEC مشابهی از یک تست حرارتی انجام شده بروی یک نمونه پست کمپکت مشابهی از یک تست حرارتی انجام شده بروی یک نمونه پست کمپکت مراد که همان دمای آزمایشگاه است، انجام شده است.

· ۲۷ - مجله سیستمهای پردازشی و چندرسانهای هوشمند- سال اول- شماره اول-پاییز ۱۳۹۹



شکل ۸: توزیع دمایی سیم,پیچهای فشار قوی وقتی ترانسفورماتور در داخل پست کمپکت قرار دارد

با در نظر گرفتن د مای محیط و افزودن مقدار د مای آن به مقدار میانگین افزایش دمای سیمپیچها به نتایج جالبی میرسیم که جدول (۴) بهصورت خلاصه این نتایج را آشکارا بیان میکند.

جدول ۴: خلاصه بندی نتایج حاصل از روشهای مختلف برای ترانس
۵۰ کیلو ولت آمیر

	انــــــدازه گــیـریــهـای آزمایشگاهی	تحليل اجزاء محدود	تســـــــت افزایش دما
دمـای مـحـیـط مـورد آزمایش	۲۰ درجـــه سانتی گراد	۲۰ درجـــه سانتی گراد	۴۰ درجــه سانتی گراد
بیشینه دمای سیمپیچیهای فشار قوی (ترانس در داخل پست قرار ندارد)	۸۱ درجـــه سانتی گراد	۷۸/۰۴ درجه سانتی گراد	۹۵/۳ درجه سانتی گراد
بیشیینه دمای سیمپیچیهای فشار ضعیف (ترانس در داخل پست قرار ندارد)	۸۹ درجـــه سانتی گراد	۸۷/۲۵ درجه سانتی گراد	۹۸/۸ درجه سانتی گراد
بیشینه دمای سیمپیچیهای فشار قوی (ترانس در داخل پست قرار دارد)	_	۸۳/۷۴ درجه سانتی گراد	۱۰۴/۵درجه سانتی گراد
بیشینه دمای سیمپیچیهای فشار ضعیف (ترانس در داخل پست قرار دارد)	_	۹۲/۹۵ درجه سانتی گراد	۱۰۸/۸درجه سانتی گراد
میـزان افـزایـش دمـا ســیمپیچیهای فشــار قوی در دو حالت	-	۵/۷ درجه سانتی گراد	۱۰ درجــه سانتی گراد

با توجه به جدول (۴) میتوان دید که در نتایج تست حرارتی که برای یک نمونه پست کمپکت ۵۰ کیلو ولت آمپر انجام شده است میزان افزایش دمای سیم پیچیهای فشار ضعیف و قوی حدودا ۱۰ درجه سانتی گراد میباشد که این نتیجه با نتیجه حاصل از آنالیز اجزاء محدود که این افزایش دما را در حدود شش درجه برای سیم پیچیهای فشار ضعیف و قوی نشان میدهد، مطابقت دارد. البته این اختلاف با توجه به تفاوت دماهای محیطی که برای پست در نظر گرفته شده قابل توجیه است.

۵- تعیین کلاس حرارتی پست بر اساس تفسیر نتایج

کلاس حرارتی یک پست کمپکت به میزان اختلاف افزایش دمای بین تران سفورمر در داخل پست و همان تران سفورمر در خارج از پست، در وضعیت بهره برداری نرمال و بار نامی، اطلاق می شود. کلاس های حرارتی پست که برای تعیین ضریب بار ترانسفورمر مورد استفاده قرار می گیرد شامل شسش کلاس حرارتی ۱۸۵، ۱۰۸، ۱۵۸، ۲۰۸، ۲۵۸، ۳۰ است، که برای مثال ۱۰۴ یعنی اختلاف بین د مای اطراف ترانسفورمر مورد بهره برداری در داخل پست و همان ترانسفور ماتور در بیرون پست، ۱۰ درجه سانتیگراد یا ۱۰ درجه کلوین است. همانطور که دکر شد ضریب بار تران سفورمر داخل پست کمپکت بر ا ساس کلاس حرارتی پست و با استفاده از منحنی های استاندارد ضریب بار دما تعیین می شود. یک نمونه از منحنی ضریب بار - دما برای ترانسفورمرهای روغنی در شکل (۹) آمده است.



شکل ۹: منحنی ضریب بار -دما برای ترانسفورمرهای روغنی

_____ Care 6

____Cass 10

نتایج بدست آمده از تحلیل اجزاء محدود در تعیین بیشترین دمای سیمپیچیهای ترانسفورمر وقتی در خارج از پست کمپکت قرار دارد با وقتی که در داخل پست کمپکت قرار دارد وجود حدود شش درجه اختلاف دما را نشان میدهد که با در نظر گرفتن تقریبهای اعمال شده، کلاس حرارتی پست کمپکت مورد نظر ۱۰k در نظر گرفته میشود.

۵– نتیجه

برای نتایج تحلیلهای مغناطیسی و حرارتی اجزاء محدود انجام شده بر روی ترانسفورمر وقتی که در خارج از پست قرار دارد و نیز وقتی در داخل پست قرار دارد حاکی از انطباق خوب این نتایج با نتایج تستهای آزمایشگاهی است و میتوان از تفسیر نتایج این تحلیلهای نرم افزاری برای تهیه جدول ضریب بار-دما ترانسفورمر پست کمپکت، که در اختیار خریدار قرار می گیرد، استفاده کرد. ضمنا ذکر این نقطه که استفاده از تحلیلهای نرم افزاری همیشه قابل دستر سی بوده و هزینه بسیار کمی در مقایسه با هزینههای انجام تستهای آزمایشگاهی در قبال صرف مقادیر زیادی پول، زمان و نیز خطر آسیب دیدن پست در افزاری را هر چه بیشتر آشکار میکند.

مراجع:

[1] مجموعه كاتالوگهاى شركت توسعه پستهاى ايران ترانسفو

[2] مجموعه كاتالوگهاي شركت ايران ترانسفو

[3] S. C. Bell, P. S. Bodger, "Power Transformer Design Using Magnetic Circuit Theory and Finite Element Analysis-A Comparison of Techniques," Australia Power Electric Conference, 2007; 607-612.

[4] N.E. Mastorakis, C. A. Bulucea, M. C. Popescu, "Transformer Electromagnetic and Thermal Models," 9th WSEAS International Conference on Power Systems,108-116.
[5] G. Swift, T.S. Molinski, R. Bray, A. Manzies, Fundamental Approach to Transformer Thermal Modeling-Part II: Field Verification," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 16, no. 2, pp. 176-180, 2001.

[6] G. L. Alegi, W. Z. Black, "Real Time Thermal Model for An Oil-Immersed Forced-Air Cooled Transformer," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 5, no. 2, pp. 991-999, 1990.
[7] W. H. Tang, O.H. Wu, Z. J. Richardson, Equivalent Heat Circuit Based Power Transformer Thermal Model," IEE Proceedings-Electric Power Applications, vol. 149, no. 2, pp. 87-92, 2004.

[8] D. Susa, M. Lehtomen, H. Nordman H, "Dynamic Thermal Modeling of Power Transformers," IEEE Transactions on Power Delivery, vol.20, no. 1, pp. 197-204, 2010.

[9] K. M. Takami, J. Mahmoudi, "Numerical Modeling of Heat Generation and Distribution in the Core and Winding of Power Transformers," International Journal of Emerging Electric Power Systems, vol. 9, no. 2, pp. 75-90, 2010.

[10] J. Faiz, M. B. Sharifian, A. Fakhri, "Oil- Immersed Transformer Thermal Modeling," Euro. Transaction Electric Power, vol. 18, pp. 577-594, 2012.